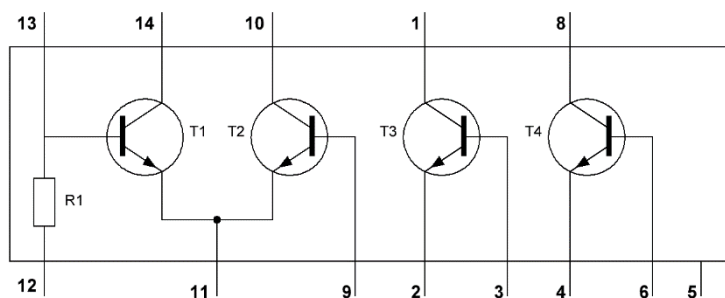
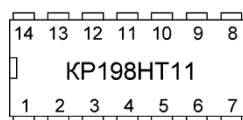


Микросхема КР198НТ11



Назначение выводов: 1 - коллектор УГ3; 2 - эмиттер УТ3; 3 - база УТ3; 4 - эмиттер УТ4; 5 - подложка; 6 - база УГ4; 7 - свободный; 8 - коллектор VT4; 9 - база VT2; 10 - коллектор УГ2; 11 - эмиттеры VT1 и VT2; 12 - резистор смещения базы VT1; 13 - база VT1; 14 - коллектор VT1.

Вывод 5 микросхемы должен быть соединен с наиболее отрицательной точкой схемы применения для сохранения изоляции между транзисторами и обеспечения их нормальной работы.

Электрические параметры

Напряжение насыщения база – эмиттер < 1 В
Напряжение насыщения коллектор – эмиттер < 0,7В
Напряжение смещения нуля дифференциальной пары < 4 мВ
Обратный ток коллектора < 40 нА
Статический коэффициент передачи тока 60...150
Разброс коэффициента передачи тока дифференциальной пары <15%

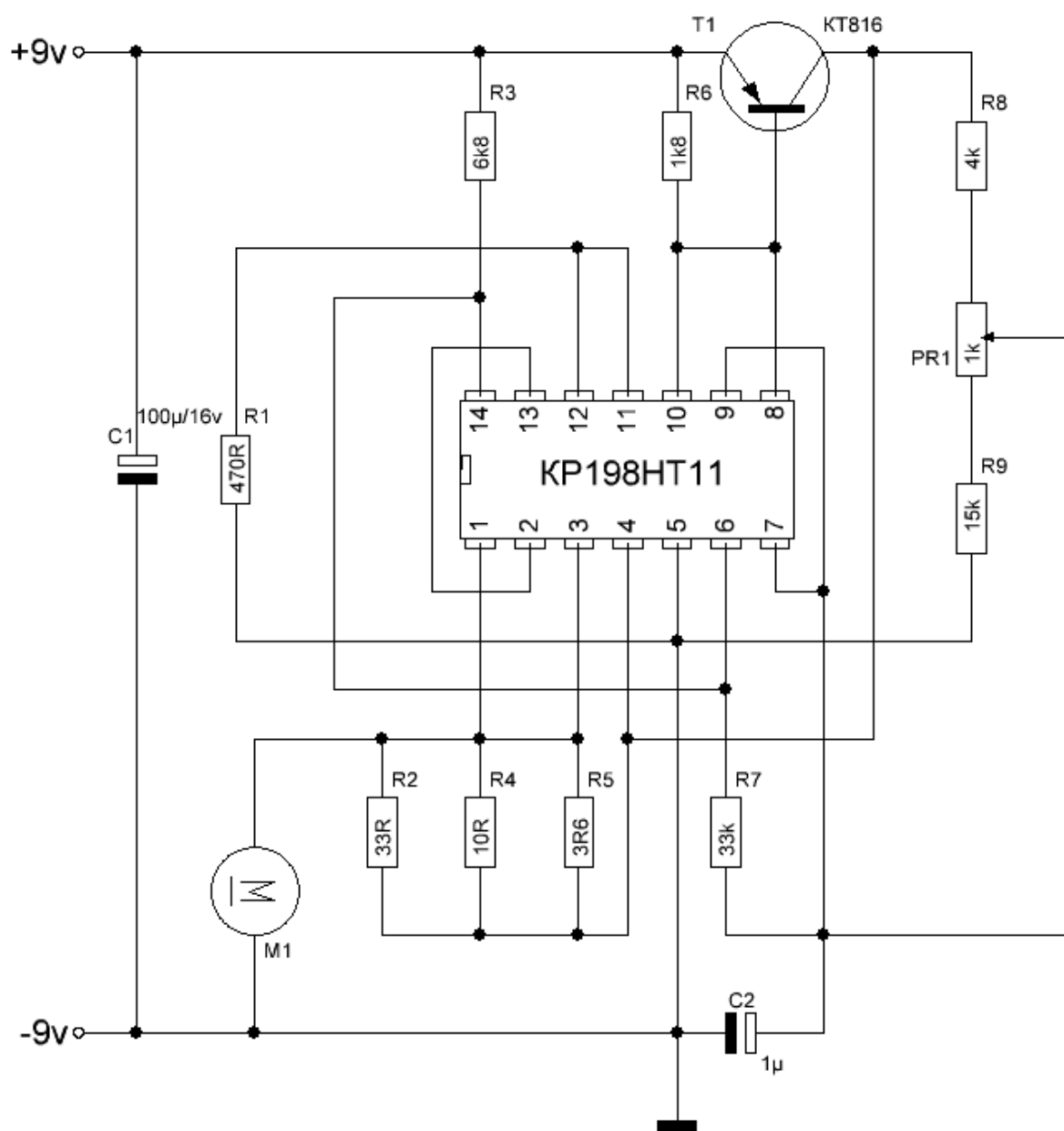
Содержание драгоценных металлов в 1000 шт микросхем

Золото 0,4227г Г-Зл 999,9

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение коллектор – база 20 В
Напряжение эмиттер - база 5 В
Импульсный ток коллектора < 50 мА
Импульсная рассеиваемая мощность матрицы < 300 мВт
Температура окружающей среды -45... +65 °С

Схема



Печатная плата

